総説 密度汎関数法を用いた黒鉛層間化合物の第一原理計算

山本雅博^{1,2}、今村裕典^{2*}

¹京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻 〒 615-8510 京都市西京区京都大学桂
 ²京都大学エネルギー理工学研究所 〒 611-0011 宇治市五ヶ庄

Modified on March 8, 2004 4:50 pm

First-principles calculation of graphite intercalation compound with density functinal theory

Masahiro Yamamoto^{1,2}, Hironori Imamura²

¹Department of Energy and Hydrocarbon Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University Nishikyo-ku, Kyoto 615-8510

²Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Uji, Kyoto 611-0011

First-principle calculations are the state-of-the-art theoretical method to explain the physico-chemical properties of solid and solid surface and owing to the predictability of the theory it gives us the guideline for the material design. In this article recent studies on the first-principles calculation of graphite intercalation compound are reviewd and our first-principles calculations on Li intercalation compunds are also shown. The calculation are in good agreement with the experimetal results reported. We also predict some results of the energy barrier for the intercaliton of Li to the stepped ghaphite surface.

KEYWORDS: Graphite Intercalation compounds, First-Principles Calculation, Density Functional Theory

1 はじめに

炭素は、ダイヤモンド・グラファイト・アモルファスカーボン 等のバルク系のみならずフラーレンに代表されるクラスター 系・カーボンナノチューブ等のワイヤー系等その形態は多彩 で、今やナノマテリアルの先頭を走るトップランナーのひと つである。中でもグラファイト層間化合物はリチウムイオン 電池の負極への実用が1990年から始まっている実用材料で ある¹⁾。グラファイト自身は炭素6原子に対して1つのリチ ウムイオンしかインターカレートしないため、容量を上昇す る試みが盛んになされている¹⁾。また、リチウムイオン電池 は起電力が高いため非水溶媒系の電解液を用いているが、炭 素負極側で電解液の分解による抵抗性皮膜が生成する問題が あり、生成機構が明らかになりつつある²⁾。それらの問題を 解決するための指針として、グラファイト層間化合物(GIC) の基本物性、GIC 表面・界面での物性を実験・理論両面から 明らかにすることが必要であると思われる。

第一原理計算は量子力学の基礎方程式である波動方程式 から始まり、電子間のクーロン相互作用以外の多体の相互作 用に密度汎関数理論 (DFT: Density Functional Theory)を 用いて、経験的なパラメータを使うことなしに系の全エネル ギー・原子間力を求める事が可能な理論解析である。系のサ イズを大きくできない実用上の問題や、DFT 理論に起因す る原理的な問題はあるが、固体、固体表面・界面(最近では

*現在所属(株)日鉱金属

液体、固液界面)について多大な成功を収めてきた。第一原 理計算の最も成功した例 としてカーボンナノチューブの伝 導性の予測が挙げられる。グラファイトのシートを丸め込ん だとみなされるナノチューブはその径及び巻き方により半導 体になったり金属になったりすることが、半経験的^{3,4)} およ び第一原理計算^{5,6)} により実験結果よりも先に予測された。 その後 STM-STS 測定によりこの予測が実験的に確かめら れた^{7,8)}。以上のことは、第一原理計算が物性予測可能性を 持っていることを示した代表例の一つとなっている¹。

1985年までのグラファイト層間化合物の電子状態と物性 (構造、電気的・磁気的性質、超伝導)に関しては上村と大野 による非常にすぐれたレビュー¹⁰⁾があるのでそれ以後の発 展でかつ重要と思われる研究についてここでは紹介したい²。 また我々が、行った計算結果¹¹⁾についても紹介したい。

2 グラファイト及び GIC の理論モデル

材料を対象とする理論計算では、求める物性の精度に応じ て、1)経験権的なモデルポテンシャルを用いた分子シミュ レーション(分子動力学法・モンテカルロ法)、2)経験的な パラメータを用いた電子論を考慮に入れた半経験的モデル、 3)完全な量子力学モデルである第一原理計算に大別できる。

¹LDA+GW 近似を用いたバンドギャップのより正確な計算が最近報告 された⁹⁾。

²上村と大野は、GIC の基礎的物性について詳細に記述しているが、リ チウムイオン電池開発以前のインターカレーション電池について最終章で 言及しているのも興味深い。

炭素を扱う理論においても経験的なポテンシャルを Tersoff¹²⁾及び Chelikowsky¹³⁾が提唱している。また、環境に依 存する強結合モデル (Enviromental dependent tight binding model) に基づいた半経験的理論が Wang らによって提唱さ れており^{14,15)}ダイヤモンド、グラファイト、アモルファス カーボンのみならずフラーレンに代表されるクラスター系、 液体についてもその物性を非常によく再現することが知られ ている。しかしながら、GIC のような電荷移行がある系で は電荷移行を考慮したモデルポテンシャルの構築は困難で、 通常は電荷移行とポテンシャルを自己無撞着に解く必要があ る。従って、経験的あるいは半経験的モデルホテンシャルに より系を精度よく記述することは難しく、第一原理計算が必 要となる。

密度汎関数理論 (DFT) に基づいた第一原理計算には様々 な手法がある。Schrödinger 方程式に相当する Kohn-Sham 方程式を3次元的に解く際に,実空間で解くかフーリエ変換 された逆格子空間で解くかで量子化学計算系とバンド計算系 に大別される。量子化学計算は孤立分子・クラスター系の計算 には良いが、GIC のような周期系には適さない。周期系の物 質の電子状態を3次元逆格子空間で解く(すなわちバンド計) 算)手法として平面波基底系を用いた計算がよく利用されて いる。平面波基底系を用いた計算の中でも内殻レベルまで考 慮した全電子計算である FLAPW(Full-potnetial Linearized Augumented Plane Wave) 法と結合に関与する価電子のみ を考慮した ab-initio 擬ポテンシャル法及びウルトラソフト 擬ポテンシャル法がよく報告されている。これらの計算は平 面波基底系であるため, LCAO 系基底と異なり平面波の数 を増やしていけば計算は単純に収束してゆく。計算に用いる 逆格子点の数, FFT 格子点の数, 計算するバンドの数, 用 いる密度汎関数法の種類 「局所密度近似 LDA(Local Denisty Approximaton), 一般化された勾配近似 GGA(Generalized Gradient Appriximation)の汎関数形],電子ポテンシャルの 性質に計算精度は依存する。炭素の場合、炭素の p 軌道の 擬ポテンシャルは 2p 動径波動関数が nodeless であることか ら、擬ポテンシャルは深くなり、計算では平面波の数を十分 とる必要がある¹⁶⁾。例えば、Troullier-Martins 型の擬ポテ ンシャルでは、エネルギーが収束するには 1360 eV 程度のエ ネルギーを持つ平面波が必要であるが、通常の計算では680 eV 程度のエネルギーをもつ平面波を用いている。ダイヤモ ンドの場合、平面波を 680 eV から 1360 eV のエネルギー をもつ平面波にまで拡張した場合、エネルギーは 60 meV / atom 程度減少する。炭素の場合グラファイトとダイヤモン ドの全エネルギー差は 20 meV / atom であり [計算誤差 (ほ ぼ 10 meV / atom) と近い値である。]、平面波の数によっ てグラファイトが安定になったりダイヤモンドが安定になっ たりするので注意を要する¹⁷⁾。GICの第一原理計算につい て述べる前に、グラファイト自身の電子構造についてまず述 べたい。

3 強束縛 (TB: Tight Binding) モデル によるグラファイトの電子構造

DFT に基づいた第一原理計算は、計算結果は正確であるが その結果を直感的に解釈することは容易ではない³。ここで は、比較的直感に訴えやすい強束縛(TB: Tight Binding Approximation)モデルでグラファイトの電子構造について求め る方法を説明し、実験結果と比較する。

系の Scrödinger 方程式は

$$H|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle = \varepsilon_{n\mathbf{k}}|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle \tag{1}$$

となる。ここで、H は系のハミルトニアン、 $|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle$ は逆格子 空間での k 点におけるバンドの指標 n で表された波動関数、 $\varepsilon_{n\mathbf{k}}$ は $n\mathbf{k}$ で指定される固有値である。m 番目の格子ベクト \mathcal{W} R_m、格子内の i 番目の原子位置ベクトル(基:basis) $\vec{\tau}_i$ に中心をもつ局在した波動関数 $\varphi_{i\alpha}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m - \vec{\tau}_i)$ を用いた Bloch 和を用いて、波動関数 $|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle$ は以下のように表される。

$$|\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \times$$
(2)
$$\sum_{\mathbf{r}} e^{i\mathbf{r}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \times$$

$$\sum_{m,i,\alpha} C^{i}_{i\alpha,\mathbf{k}} \mathrm{e}^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}_{m}+\vec{\tau}_{i}-\mathbf{r})} \varphi_{i\alpha}(\mathbf{r}-\mathbf{R}_{m}-\vec{\tau}_{i})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m,i,\alpha} C^{n}_{i\alpha,\mathbf{k}} \mathrm{e}^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R}_{m}+\vec{\tau}_{i})} |mi\alpha\rangle \qquad (3)$$

$$|mi\alpha\rangle = \varphi_{i\alpha}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m - \vec{\tau}_i)$$
 (4)

ここで、 α は s, p_x, p_y, p_z 等の原子波動関数の軌道を表す指標であり、 $N = \sum_m$ はセルの数である。Eq. (1)の左辺から $\langle 0j\beta |$ を作用させると

$$\sum_{i\alpha} H_{j\beta,i\alpha}(\mathbf{k}) C_{i\alpha,\mathbf{k}}^{n} = \varepsilon_{n\mathbf{k}} C_{j\beta,\mathbf{k}}^{n}$$
(5)
$$H_{j\beta,i\alpha}(\mathbf{k}) = \sum_{m} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R}_{m} + \vec{\tau}_{i} - \vec{\tau}_{j})} \langle 0j\beta | H | mi\alpha \rangle$$
(6)

ここで原子軌道はお互いに正規直交系であるとした。

$$\langle m'j\beta|mi\alpha\rangle = \delta_{mm'}\delta_{ij}\delta_{\alpha\beta} \tag{7}$$

 $C_{i\alpha,\mathbf{k}}^{n}$ は $\psi_{n\mathbf{k}}$ の規格化条件から

$$\langle \psi_{n\mathbf{k}} | \psi_{n\mathbf{k}} \rangle = \sum_{i,\alpha} C^{n*}_{i\alpha,\mathbf{k}} C^n_{i\alpha,\mathbf{k}} = 1$$
 (8)

となる。行列要素 $\langle 0j\beta|H|mi\alpha\rangle$ は、運動エネルギー演算子 \hat{T} 及び k 番目のセル、l 番目の原子に中心をもつポテンシャ $\mathcal{W} v_l(\mathbf{r} - \mathbf{R}_k - \vec{\eta})$ で

$$\langle 0j\beta | H | mi\alpha \rangle = \langle \varphi_{j\beta}(\mathbf{r} - \vec{\tau}_j) | \hat{T} + \sum_{kl} v_l(\mathbf{r} - \mathbf{R}_k - \vec{\tau}_l) \\ | \varphi_{i\alpha}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m - \vec{\tau}_i) \rangle$$
(9)

³人によっては、力任せ・計算機任せ、brute force 計算とも言われる。

と書ける。2中心近似を用いると行列要素は

$$\langle 0j\beta|H|mi\alpha\rangle \simeq \langle \varphi_{j\beta}(\mathbf{r}-\vec{\tau}_{j})|\hat{T}+v_{j}(\mathbf{r}-\vec{\tau}_{j}) +v_{i}(\mathbf{r}-\mathbf{R}_{m}-\vec{\tau}_{i})|\varphi_{i\alpha}(\mathbf{r}-\mathbf{R}_{m}-\vec{\tau}_{i})\rangle$$

$$(10)$$

となる。炭素がもつ 2s²2p² の 4 つの価電子の内、3 つの価電 子は sp² 混成軌道を構成しグラファイトシート面内で σ 結合 を作る。残りの 1 つの価電子は、シート面に垂直な p_z 軌道よ り作られる π 軌道を作る。以下この $pp\pi$ 結合について考えよ う。 $\alpha, \beta = p_z \equiv z$ と置けば、 $r = |\mathbf{r}_{0j,mi}| = |\mathbf{R}_m + \vec{\tau}_i - \vec{\tau}_j| \neq 0$ の原子間行列要素(非対角成分)は、

$$\langle 0jz|H|miz\rangle$$

$$= \left(\frac{\mathbf{r}_{0j,mi}^{z}}{r}\right)^{2} V_{pp\sigma}(r)$$

$$+ \left[1 - \left(\frac{\mathbf{r}_{0j,mi}^{z}}{r}\right)^{2}\right] V_{pp\pi}(r)$$

$$(12)$$

ここで $\mathbf{r}_{0j,mi}^{z}$ は $\mathbf{r}_{0j,mi}$ の z 成分である。 r = 0 である原子内行列要素(対角成分)は、

$$\langle \varphi_{i\beta}(\mathbf{r} - \vec{\tau}_i) | \hat{T} + v_i(\mathbf{r} - \vec{\tau}_i) \\ + \sum_{mj}' v_j(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m - \vec{\tau}_j) | \varphi_{i\alpha}(\mathbf{r} - \vec{\tau}_i) \rangle \\ = \delta_{\alpha\beta} \epsilon_{\alpha} + \sum_{mj}' I_{\beta\alpha}(|\mathbf{r}_{0i,mj}|)$$
(13)
(14)

ここで、右辺第 2 項目の和についている ' は $|\mathbf{r}_{0i,mj}| = 0$ を除くことを意味する。また、 $I_{\beta\alpha}$ は

$$I_{\beta\alpha}(r) \equiv I_{\beta\alpha}(|\mathbf{r}_{0i,mj}|)$$

= $\langle \varphi_{i\beta}(\mathbf{r} - \vec{\tau}_i) | v_j(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m - \vec{\tau}_j) | \varphi_{i\alpha}(\mathbf{r} - \vec{\tau}_i) \rangle$
(15)

で定義され、*pz* 軌道に対して、原子行列要素は

$$(E_z)_i = \epsilon_z + \sum_{mj} \left\{ \left(\frac{\mathbf{r}_{0i,mj}^z}{r} \right)^2 I_{pp\sigma}(r) + \left[1 - \left(\frac{\mathbf{r}_{0i,mj}^z}{r} \right)^2 \right] I_{pp\pi}(r) \right\}$$
(16)

となる。

今、グラファイト単一層 (graphene) を考える。その 2 次 元単位格子ベクトル **a**₁, **a**₂ 及び $\vec{\tau}_1, \vec{\tau}_2$ は、

$$\begin{array}{rcl} {\bf a}_1 & = & (\frac{\sqrt{3}}{2}a, -\frac{a}{2}, 0) \\ {\bf a}_2 & = & (0, a, 0) \\ r_{\rm NN(nearest\ neighbor)} & = & \frac{a}{\sqrt{3}} = 1.418 {\rm \mathring{A}} \\ r_{\rm NNN(next\ nearest\ neighbor)} & = & a = 2.455 {\rm \mathring{A}} \\ \vec{\tau}_1 & = & 0, \qquad \vec{\tau}_2 = \frac{1}{3} {\bf a}_1 + \frac{2}{3} {\bf a}_2 \end{array}$$



Figure 1: The lattice and basis vector of graphene.

$$\mathbf{b}_{1} = \frac{4\pi}{\sqrt{3}a}(1,0)$$

$$\mathbf{b}_{2} = \frac{4\pi}{\sqrt{3}a}(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$$

表面ブリルアン・ゾーン内の対称な点¹⁸⁾を以下のように定 義する。

$$\bar{\Gamma} = 0 \bar{K} = \frac{1}{3}\mathbf{b}_1 + \frac{1}{3}\mathbf{b}_2 \bar{M} = \frac{1}{2}\mathbf{b}_1$$

 $_{3)}$ $ar{K}-ar{\Gamma}-ar{M}-ar{K}$ でのバンドを計算しよう。基ベクトルは2



Figure 2: Surface Brillouin zone of graphene.

種類なので解くべき永年方程式は、Eq.(5)から

$$\begin{vmatrix} H_{1z1z} - \epsilon_{n\mathbf{k}} & H_{1z2z} \\ H_{2z1z} & H_{2z2z} - \epsilon_{n\mathbf{k}} \end{vmatrix} = 0$$
(17)

でその解は

$$2\epsilon_{n\mathbf{k}} = H_{11} + H_{22} \\ \pm \sqrt{(H_{11} + H_{22})^2 - 4(H_{11}H_{22} - H_{12}H_{21})}$$
(18)

ここで添え字の *z* は省略した。Xu ら¹⁹⁾ による炭素の多態に 移植可能な TB パラメータを用いると

$$\frac{V_{pp\pi}(r_{\rm NN})}{V_{pp\pi}(r_{\rm NNN})} \simeq 201 \tag{19}$$

となるので最近接原子の $V_{pp\pi}(r_{\rm NN})$ だけを考えればよい。また、grapheneの場合 $\mathbf{r}_{0i,mj}^{z} = 0$ なので Eq. (12)より $V_{pp\sigma}$

の寄与は考慮しなくてよい。最近接のみの原子間行列要素を 考慮すればよいので H_{11}, H_{12} は、

$$H_{11} = \sum_{m} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_{m}} \langle 01z|H|m1z \rangle \sim \langle 01z|H|01z \rangle = E_{z}$$
$$= H_{22}$$
(20)

$$\epsilon_{n\mathbf{k}} = E_z \pm \sqrt{H_{12}H_{21}} \tag{21}$$

となる。Eq. (6) より以下の k 点に対して *H*₁₂, *H*₂₁ を求める と、表面ブリルアン・ゾーンでの対称な線に沿った k 点での 電子のエネルギーは

$$\epsilon_{n\mathbf{k}} = E_z \pm [1 + 2\cos(2\pi t/3)]V_{pp\pi}(r_{\rm NN})$$

[for $\bar{\Gamma}(t=0) - \bar{K}(t=1)$] (22)

$$\epsilon_{n\mathbf{k}} = E_z \pm \sqrt{5} + 4\cos(\pi t)V_{pp\pi}(r_{\rm NN})$$

[for $\bar{\Gamma}(t=0) - \bar{\mathbf{M}}(t=1)$] (23)

$$\epsilon_{n\mathbf{k}} = E_z \pm \{3 + 2[\cos(2\pi t/3) + \cos(\pi + \pi t/3) + \cos(\pi - \pi t/3)]\}^{1/2} V_{pp\pi}(r_{\rm NN})$$
[for $\bar{M}(t=0) - \bar{K}(t=1)$] (24)

となる。例として、 $\overline{\Gamma}$ 点における π 軌道のイメージを Fig. 3 に示す。今、 $E_z = 0, V_{pp\pi}(r_{\rm NN}) = -2.9$ eV とした時のバ



Figure 3: Image of the bonding π orbital at the zone center.

ンド構造を Fig.4 の実線に示す。graphene の LDA+GW 近 似 (graphene の場合 LDA 計算と GW 計算ではバンド構造 に大きな差は見られない。)による Miyake らによる計算結 果⁹⁾を で示した。結合性の π 軌道は、 \bar{K} 点での縮退および エネルギー分散は TB 近似と第一原理計算は良く一致した。 ただし、反結合状態である π^* 軌道は、TB モデルでは結合 軌道と完全に対称であるが、LDA+GW 計算では \bar{K} 点近傍 以外では結合軌道と反結合軌道はフェルミ準位に対して対称 ではない。

グラファイトでは、grahenene 層が ABAB と積層した構造 をもつ。格子ベクトルは、上で述べた 2 つのベクトルに加えて $\mathbf{a}_3 = (0,0,c)$ が必要となる。ここで、c はグラファイト面間隔 の 2 倍である。basis ベクトルは、上で述べた 2 つの basis (A 層) に加え、B 層では $\vec{\tau}_3 = (1/2)\mathbf{a}_3, \vec{\tau}_4 = (2/3)\mathbf{a}_1 + (1/3)\mathbf{a}_2 + (1/2)\mathbf{a}_3$ となる。 ノルム保存擬ポテンシャル (NCPP:Normconserving Pseudo-Potential) 法で我々が行ったグラファイ トのバンド計算結果を Fig.5 に示す。また、グラファイトで の角度分解光電子分光の実験結果²⁰⁾ から求めたバンド構造 を、Fig.4 に で示した。グラファイト面間の相互作用によ リ π, π^* 軌道ともに分裂する。特に、K 点で、層方向上下に 炭素を持つ basis $\vec{\tau}_1, \vec{\tau}_3$ の炭素は、フェルミレベル (Fig.4 で 0 eV)で上下に分裂するが、層方向上下に炭素を持たない basis \vec{r}_2, \vec{r}_4 の炭素では graphene のバンド同様準位は分裂し ないで2 重に縮退する。

グラファイト (0001) 基底面を走査トンネル顕微鏡 (STM) で観察すると、面内のすべての原子が観測されるのではなく c軸方向で上下に炭素を持つ $\vec{\tau}_1$ (または $\vec{\tau}_3$) は STM では観 測されない「隠れた原子」である事が示唆された²¹⁾。この 現象は上記に示した K 点近傍での電子レベルの分裂によっ て引き起こされることが第一原理計算により示された^{22,23)}。 低温で pN オーダーの力を測定可能な AFM によるグラファ イト (0001) 面の観測で、面内すべての原子像が得られたこ とから、STM での「隠れた原子」の現象は電子状態に由来 することが実験的にも確認された²⁴⁾。 Fig.6 には、ブリル



Figure 4: electronic structure of graphene. solid line(TB calculation), filled square(LDA-GW calculation),⁹⁾ open circle (experemental results)²⁰⁾



Figure 5: LDA calculation of graphite band

アン・ゾーン内の816個のk点から求めた状態密度を示す。 フェルミレベルで状態密度がゼロになり半金属の状態になっ ている。また、Fig.7にはグラファイト面に垂直な面での価 電子密度を示す。最近接 C-C 間に価電子が集まる共有結合 を有し、グラファイト面間には価電子密度はほとんど無い。 この面間にインターカラントが入っていき、グラファイト層 と電子の授受を行う。その他グラファイトのバンド構造の詳細は金森・寺倉の解説²⁵⁾を参照頂きたい。

グラファイトの電子構造に関してはこれらの電子構造を TB モデルで再現することは可能であるが、系の全エネル ギーを求めるためには、さらに付加的な項を fitting により 求める必要がある^{15,19)}。また、GIC のような電荷の移動が ある2成分系の TB モデルによるモデルの構築は容易ではな い。一方、第一原理計算では直感的な理解は難しいが、fitting parameter なしに精度良く計算可能な全エネルギー計算から 物性を得ることができる。従って、以降は DFT に基づいた 第一原理計算について述べる。 第一原理計算は材料の物性



Figure 6: Density of states of graphite.



Figure 7: Charge contour of graphite (110) plane.

を説明する上で最も成功してきた理論計算の一つであるが、 第一原理計算も問題が無いわけではない。計算量(CPU時 間)は原子数の3乗、計算容量(メモリー)は原子数の2乗 に比例するため基本セル内の原子数に限界がある。有限温度 の物性を得るには、サブ fs の時間ステップで計算する分子動 力学と組み合わせる必要があるため、原子数の少ない・短時 間の現象以外への適用はいまだに簡単ではない。また、電子 間の多体の相互作用を DFT の LDA 又は GGA で近似して いることによる問題も多い。グラファイトのような層状化合 物の場合、面間に働く引力は van der Waals(vdW) 力による とされている。この引力は電子密度の揺らぎに基づく長距離 力なので、LDA や GGA では説明されない。我々のグラファ イト面内 C-C 結合距離と面間距離に関する FLAPW の計算 結果を Figs.8,9 に示す。Fig8 は CA 型²⁶⁾ の LDA²⁷⁾ による 計算結果で、Fig9 は PBE 型の GGA²⁸⁾ により計算された ものである。LDA、GGA どちらの計算も面内の炭素間距離 (d = a)は、実験値の 4.641 au (1 au = 0.529177 Å) に近い値 となっている。一方、面間隔の距離は、LDA-CA では実験結 果 12.654 au よりも 1%短い結果となったが、GGA では面間 隔に安定な位置は見いだせなかった。LDA-CA の場合に良く 一致するのはおそらく偶然の産物で、LDA より GGA が近似 が悪いことを意味するものではない。ごく最近、vdW-DFT を用いて Rydberg らはグラファイトの面間の vdW 引力を第 一原理計算により求めた²⁹⁾。面間の距離は 12%程度過大評 価しているが、経験的なパラメータのない第一原理計算から グラファイトの面間に働く力が vdW 力であることが示され た意義は大きい。



Figure 8: LDA-CA calculation of the energy dependence of the lattice constants of graphite. The upper figure is energy change by the in-plane lattice constant ength and the lower figure is the energy change by the interplane lattice constant.

11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 c (au)

4 GICの第一原理計算の報告例

以下では、上村と大野による 1985 年のレビュー¹⁰⁾ 以降に報 告された GIC の第一原理計算について紹介する。

Chan らは³⁰⁾、インターカラントとグラファイト層の間の 正負の電荷移行と面内 C-C 間距離の増減(最大1%程度)に 普遍的な関係があることを、NCPP 法を用いた第一原理計算 を用いて示した。また、電荷移行とラマン活性な E_{2g_2} モード および赤外活性な E_{1u} モード (Fig. 10 に振動モードを示す。) について第一原理計算とインターカラントを挟む層間にカッ プリングを仮定して、実験結果を説明した³¹⁾。但し、この計



Figure 9: GGA-PBE calculation of the energy dependence of the lattice constants of graphite. The upper figure is energy change by the in-plane lattice constant ength and the lower figure is the energy change by the interplane lattice constant.

算では、インターカラントを点イオンとして扱い、MC2の形 で点イオンを配置している。Kohanoffら³²⁾は、ステージ1 の LiC_6 の構造は、 $A\alpha A\alpha A\alpha$ の積層構造が $A\alpha A\beta A\gamma$ の積層 構造に比べて LiC₆ 当たり 14meV 安定であることを NCPP 法により示した。この値は、我々が NCPP、及び FLAPW 法で計算した AB 積層グラファイトと AA 積層グラファイト の炭素6原子あたりのエネルギー差(82meV)よりもかなり 小さい値である。Ahuja らは³³⁾、FPLMTO(Full-Potential Linearized Muffin-Tin Oribital)法により LiC₆の電子状態を 計算し、電子状態から異方性をもつ周波数依存の複素誘電率、 反射率を求め、実験結果と一致することを示した。Hartwigsen らは³⁴⁾、NCPP 法を用いてステージ1のアルカリ金属への 電荷移動量を求めた。電荷移動量は定義によって任意性があ るが、詳細な解析により LiC₆ では 0.52、MC₈,(M=Na, K, Rb, Cs) では 0.7 個の電子がアルカリ金属からグラファイト 層に移行することを示した。Liの値が小さいのは、C-Li間 に共有結合性があるためであることを電子密度の凝集による 変化より明らかにした。Kganyago らは³⁵⁾、Fig.9 に示した ように GGA ではグラファイト面間の距離が正しく求めるこ とができないことを示した。最近彼らは LDA では、LiC₆の 生成エンタルピ-0.145 eV が実験結果 (-0.14 ± 0.01 eV) とよ く一致することを示した³⁶⁾。後で示すように、彼らの実験 結果の解析には問題があるように思う。Balbuenaのグルー プでは、Li と電池で使われている非水溶媒系およびグラファ イトとの相互作用の量子化学計算37-39)および分子動力学計 算⁴⁰⁾を行い、より実際の応用に近い系について詳細な解析 を行った。Han らも⁴¹⁾ 非水溶媒の分解について量子化学計 算を行い、溶媒の安定性について議論をおこなった。



Figure 10: Zone-center optical phonon mode of graphite.

5 Li-GIC の第一原理計算:バルク及び ステップ表面

- 5.1 バルク
- 5.1.1 エネルギー・構造

以上では、1986年以降の GIC の第一原理計算についての代 表例を簡単に紹介した。以下では、Li の GIC のバルクおよ びステップ表面における我々の FLAPW(Wien97) 法による 計算結果¹¹⁾を紹介したい。FLAPW 計算に用いたパラメー ター等計算の詳細はここでは述べないが、前述の理由により 密度汎関数は LDA-CA を用い、平面波の数による全エネル ギーの収束は事前に充分に検討した。

これまでの報告例を参考に Li のグラファイトへの挿入が Table 1 と Fig. 11 で示されるステージおよび面内構造をと るとし、全エネルギーの計算を行った。グラファイト層の積 層構造は LiC₆ で報告されている⁴²⁾ AAA 構造とした。

Table 1: The stage and intra-plane superlattice structure of Li-GIC for firtst-priciples calculation. * means that the sturucture is the hypothetical one.

Li-GIC	Stage structure	in-plane structure
LiC_2	Stage-1	1×1
(High presseure phase)		
LiC_4 *	Stage-1	1×2
LiC_6	Stage-1	$\sqrt{3} \times \sqrt{3}$
LiC_8	Stage-1	2×2
LiC_{12}	Stage-2	$\sqrt{3} \times \sqrt{3}$
LiC_{16}	Stage-2	2×2

Figure 11: Li intercalation process to graphite

全エネルギー計算により構造最適化された Li-GIC 系のエ ネルギー、格子定数および対応する実験値を Table2 に示す。 グラファイト及び LiC₆ での格子定数は報告されている実験 結果と良く一致した。Li の挿入に伴う C-C 最近接距離の変 化を Fig.12 に示した。LiC₆ までの格子の面内方向の伸びは 実験結果とよく一致した。

エネルギーに関して、以下の反応を考える。

$$Li(bcc solid) + C_x(graphite) \rightarrow LiC_x$$
 (25)

Li 原子当たりの $E(\theta)$ を以下のように定義すると

$$E(\theta) = E_{\text{LiC}_{x}(\text{LIG})}^{\text{total}} - E_{\text{C}_{x}(\text{graphite})}^{\text{total}} - E_{\text{Li(bcc solid)}}^{\text{total}}(26)$$

$$\theta = 1/x \qquad (27)$$

(θが大きいほど、Liは高濃度になることに注意。)Li原子
 1個の出入りに関する化学ポテンシャル μ_{tot}を以下の式で

Figure 12: Elongation of the nearest neighbor C-C distance with the Li intercalation. $\theta = 1/x$ of LiC_x .

定義した。

$$\mu_{\text{tot}} = \frac{\partial [N_{\text{Li}}E(\theta)]}{\partial N_{\text{Li}}} = E(\theta) + \theta \frac{\partial E(\theta)}{\partial \theta}$$
(28)

その結果を以下に示す。生成エネルギーはLiC₆に相当する

Figure 13: $\theta(=1/x \text{ of } \operatorname{LiC}_x)$ dependence of energy $E(\theta)$ of Li-GiC.

Figure 14: Calculated chemical potential of Li-GIC

濃度で最大になった。化学ポテンシャルを求める際に、 $\partial E/\partial \theta$ は、Fig. 13 中に示されている直線より求め、直線の中点に おける化学ポテンシャルを求めた。Fig.14 に化学ポテンシャ ルの計算結果を示す。この結果は、以下のような解析により 実験結果と直接比較可能である。実験では、以下の模式図 (Fig.15) に示すような Li/Li⁺ 基準での開回路電位差が求め られている。このときの、開回路電位差 ΔV は電気化学ポ

Table 2: Calculation results for Li-GIC. E is the energy per cell and 1 Ry = 13.60569 eV. d is the Li-Li nearest neighbor distance in the intercalant layer, c is the stage length, and p = l/c where l is the distance of the graphite layers between which there is no Li intercalant layer. 1 au = 0.529177 Å

		0.0-0-1	•		
	E [Ry]	d [au]	c[au]	p	a (in-plane C-C length)[au]
$AA(C_2)$	-1.311	4.620	6.843	-	2.667
$AB (C_4)$	-2.626	4.627	12.502	-	2.671
AB (exp.)		4.641	12.654	-	2.679
LiC_2	-1.4333	4.841	6.446	-	2.795
LiC_4	-2.7721	4.717	6.637	-	2.723
LiC_6	-4.1002	8.173	6.697	-	2.724
${ m LiC}_6~({ m exp.})$		8.133	7.003	-	2.711
LiC_8	-5.4115	9.339	6.676	-	2.696
LiC_{12}	-8.0291	8.047	12.688	0.467	2.682
LiC_{16}	-10.6119	9.257	12.423	0.479	2.672

Figure 15: schematic diagram of the electrochemical cell to determine the open circuit voltage (OCV) of Li-GIC vs Li/Li^+ .

テンシャルの考察により

$$e\Delta V = \mu_{\rm Li}^0 + \mu_{\rm C_x}^0 - \mu_{\rm LiC_x}^0$$
(29)

$$= -\mu_{\rm tot} \tag{30}$$

となり、Fig.14の縦軸の反対符号が実験結果から得られる開 回路電位と一致する。上で述べた Kganyago らの生成エネル ギーを電位と比較したのが正しくない理由は、この点にあ る。実験結果では、Li の占有率が増加するにつれて電位は 減少し、第4ステージから第一ステージまでは0-200 mV vs Li/Li⁺ であることが知られている。電位の濃度依存性お よびその値は我々の計算結果と一致している。

5.1.2 Liのバルク内での移動:ポテンシャル障壁

Li-GIC での、Li のインターカレーション層面内および面 垂直方向の移動の障壁を、 $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ 面内超格子構造を保ち Li の位置を変えながら全エネルギーを計算することにより求 めた。ただし、面内および面間の格子定数には LiC₆ の最安 定構造の値を用いた。それぞれの計算結果を、Fig16, Fig17 に示す。面内方向では、6角形構造の中心直上の安定なサイ トからグライファイト直上(ポテンシャル障壁は 35 mRy = 480 meV) およびグライファイト原子中点の直上(28 mRy = 380 meV) への障壁は温度に換算して 4400 K - 5500 K であり、室温(300 K) の十数倍であるのに対して、グラファ イトの6角構造の中心を横切る垂直方向の障壁(670 mRy = 9.1 eV, 110000 K に相当) は面内方向に比べて 20 倍以上 大きく、基底面の障壁を越えて移動することは考えにくい。 このことは、リチウム挿入は基底面からはおこらないという 実験結果と一致する。

Figure 16: 3D plot of the energy barrier of Li transfer in the Li interclant layer of LiC_6 .

Figure 17: Energy barrier of Li transfer in the normal direction of Li intercalant layer of LiC_6 .

5.2 グラファイトステップエッジからのリチウム の挿入

上で示したように、グラファイトの基底面からリチウムが 挿入することはほとんど不可能である。従って、グラファイ

Figure 20: Enegy barrier for Li intercalation to the stepped graphite surface (SSG). The arrow in the figure is the step-up direction.

トの端面すなわちここでは階段状の SSG(Stepped Surface Graphite)から Li がどのように挿入していくのかを調べた。 C(S)-[3(001)-(302)]構造をもつ SSG の電子構造は Kobayashi らによって報告されており、ステップに局在した電子レベルが フェルミレベルに現れることを報告した⁴³⁾。我々は、Fig.18 に示すような C(S)-[2(001)-(211)]構造をもつ SSG ヘリチウ ムが挿入していく時のエネルギーを求めた。グラファイト は本来層構造が AB 積層構造であるが、LiC₆-GIC ではグラ ファイト層はは AA 構造をとることを考慮してここでは AA 構造にした。単位セル内には炭素 12 原子、リチウム 2 原子

Figure 19: Schematic diagram of the unit cell for the calculation of stepped surface graphite. a, b, and c are 32.7093, 11.5588, and 8.17731 au, respectively.

Figure 18: Top view of the stepped C(S)- $[2(001)-(2\overline{1}1)]$ surface. The thick line is the step edge line.

をもつ2層構造の格子について計算を行った。計算に用いた ユニットセルを、Fig.19に示す。グラファイト層の面間隔は 6.676 au とした。リチウムの位置による格子の緩和は考慮 しなかった。計算結果を Fig.20 に示す。リチウムは、層間 の間を Fig.20 に示すように層の中間、ステップエッジの外 側 (薄い灰色の部分)から [100] 方向にグラファイト層内部 (濃い色の部分)移動させた。グラファイト表面での、移動 の障壁は 1.09 eV、ステップエッジを越える時の障壁は 0.48 eV、Fig.20 に示した A→B→C では、最大の 1.77 eV であ り、C→D では 0.95eV である。A サイトはまた他のどのサ イトよりも安定である。以上より我々の当初の予想とは異な リ、ステップエッジを越える時の障壁はむしろ小さく、安定 な A サイトから内部に移動する時の障壁が大きいことが明 らかとなった。障壁の値 1.77 eV は、LiC₆ での、面内方向 での値 (0.4 eV) よりも 4 倍以上大きいが、基底面を通過す る際の障壁 9.1eV よりは、はるかに小さい。リチウムのイン タカレーションがステップ (エッジ面)から進行するという 実験結果と一致するが、その障壁はかなり大きいことが明ら かとなった。

6 まとめ

グラファイトおよび Li-GIC のこれまでの報告例および我々 の計算結果について述べた。計算は、周期的な系にのみ限ら れており、また非水溶媒系が存在しないこと等現実の電気化 学系との間には大きな隔たりがあるが、ミクロスコピックな 観点にたった分光実験等の実験結果の積み重ねと理論計算の 突き合わせによって、Li-GIC の電気化学を新たな視点から 見直すことができるかもしれない。

7 謝辞

この研究を行うにあたって、共同研究者の香港科学技術大 学物理学科の C. T. Chan 教授、Ames 研究所-アイオワ州立 大物理学科の K. M. Ho 教授、Max-Plank 金属研究所の C. Elsässer 博士に感謝いたします。また、GIC につきまして議 論頂きました京都大学工学研究科の安部武志先生に感謝いた します。

文献

- 1) J. M. Tarascon, M. Armand, Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries, *Nature* **414** (2001) 359–367.
- S.-K. Jeong, Studies on surface film formation on graphite negative electrodes in lithium-ion batteries, Phd thesis, Dept. Energy and Hydorcarbon Chem., Kyoto University, Kyoto (2001).
- N. Hamada, S. Sawada, A. Oshiyama, New one-dimensional conductors - graphitic microtubules, *Phys. Rev. Lett.* 68 (1992) 1579–1581.
- R. Saito, M. Fujita, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus, Electronic-structure of chiral graphene tubules, *Appl. Phys. Lett.* 60 (1992) 2204–2206.
- J. W. Mintmire, B. I. Dunlap, C. T. White, Are fullerene tubules metallic, *Phys. Rev. Lett.* 68 (1992) 631–634.
- X. Blase, L. X. Benedict, E. L. Shirley, S. G. Louie, Hybridization effects and metallicity in small radius carbon nanotubes, *Phys. Rev. Lett.* **72** (1994) 1878–1881.
- J. W. G. Wildoer, L. C. Venema, A. G. Rinzler, R. E. Smalley, C. Dekker, Electronic structure of atomically resolved carbon nanotubes, *Nature* **391** (1998) 59–62.

- T. W. Odom, J. L. Huang, P. Kim, C. M. Lieber, Atomic structure and electronic properties of single-walled carbon nanotubes, *Nature* **391** (1998) 62–64.
- M. Miyake, S. Saito, Quasiparticle band structure of carbon nanotubes, *Phys. Rev. Lett.* 68 (2003) 155424+1–5.
- 上村洸, 大野隆央, エキゾティックメタル GIC, 2nd Edition, Vol. 7 of 物理学最前線, 共立, 東京, 1985, Ch. 1, pp. 1–92.[in Japanese]
 [H. Kamikura and T. Ohno, Exotic Metal GIC (Buturigaku Saizensen vol. 7) (Kyoritu, Tokyo, 1985) pp.1-92.]
- 今村裕典, グラファイトへのリチウムのインターカレーションに関す る理論的研究, 京都大学修士論文, 京都大学大学院エネルギー科学研究 科 (March 2000). [in Japanese]
- 12) J. Tersoff, Modeling solid-state chemistry: Interatomic potentials for multicomponent systems, *Phys. Rev. B* 39 (1989) 5566–5568.
- 13) J. R. Chelikowsky, Formation of c 60 clusters via langevin molecular dynamics, *Phys. Rev. B* 45 (1992) 12062–12070.
- 14) C. Z. Wang, K. M. Ho, Tight-binding molecular dynamics studies of covalent systems, Vol. 93 of Advances in Chemical Physics, 1996, pp. 651–702.
- 15) M. S. Tang, C. Z. Wang, C. T. Chan, K. M. Ho, Environmentdependent tight-binding potential model, *Phys. Rev. B* 53 (1996) 979–982.
- 16) N. Troullier, L. Martins, Efficient pseudopotentials for planewave calculations, *Phys. Rev. B* 43 (1991) 1993–2006.
- 17) C. T. Chan, Private communications.
- 18) 柳瀬章, ブリルアン・ゾーンとは, パリティ物理学コース, 丸善, 1997. [in Japanese] [A. Yanase, What's Brillouin Zone? (Maruzen, Tokyo, 1997)]
- 19) C. H. Xu, C. Z. Wang, C. T. Chan, K. M. Ho, A transferable tight-binding potential for carbon, 4 4 (1992) 6047–6054.
- 20) H. Nishimoto, T. Nakatani, T. Matsushita, S. Imada, H. Daimon, H. Suga, Two-dimansional angular distribution of photoelectrons of single-crsytal graphite, 8 8 (1996) 2715–2732.
- 21) G. Binnig, H. Fuchs, C. Gerber, H. Rohrer, E. Stoll, E. Tosatti, Energy-dependent state-density corrugation of a graphite surface as seen by scanning tunneling microscopy, *Europhys. Lett.* 1 (1986) 31–36.
- 22) D. Tomanek, S. G. Louie, H. J. Mamin, D. W. Abraham, R. E. Thomson, E. Ganz, J. Clarke, Theory and observation of highly asymmetric atomic-structure in scanning-tunneling-microscopy images of graphite, *Phys. Rev. B* **35** (1987) 7790–7793.
- 23) D. Tomanek, S. G. Louie, 1st-principles calculation of highly asymmetric structure in scanning-tunneling-microscopy images of graphite, *Phys. Rev. B* 37 (1988) 8327–8336.
- 24) S. Hembacher, F. J. Giessibl, J. Mannhart, C. F. Quate, Revealing the hidden atom in graphite by low-temperature atomic force microscopy, *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **100** (2003) 12539– 12542.
- 25) 金森, 米沢, 川村, 寺倉, 固体一構造と物性, Vol. 7 of 岩波講座現代 の物理学, 岩波書店, 1994, Ch. 4章. [in Japanese] [J. Kanamori, F. Yonezawa, K. Kawamura, K. Terakura, Solid-Structure and Physical Properties (Iwanami, Tokyo, 1994) Chap. 4]
- 26) D. M. Ceperley, B. J. Alder, Ground state of the electron gas by a stochastic method, 45 45 (1980) 566–569.
- 27) J. P. Perdew, A. Zunger, Self-interaction correction to densityfunctional approximations for many-electron systems, 23 23 (1981) 5048–5079.
- 28) J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made simple, *Phys. Rev. Lett.* 77 (1996) 3865–3868.
- 29) H. Rydberg, M. Dion, N. Jacobson, E. Schroder, P. Hyldgaard, S. I. Simak, D. C. Langreth, B. I. Lundqvist, Van der waals density functional for layered structures, *Phys. Rev. Lett.* **91** (2003) 126402.
- 30) C. T. Chan, W. A. Kamitakahara, K. M. Ho, P. C. Eklund, Charge-transfer effects in graphite intercalates - abinitio calculations and neutron-diffraction experiment, *Phys. Rev. Lett.* 58 (1987) 1528–1531.
- 31) C. T. Chan, K. M. Ho, W. A. Kamitakahara, Zone-center phonon frequencies for graphite and graphite- intercalation compounds charge-transfer and intercalate- coupling effects, *Phys. Rev. B* 36 (1987) 3499–3502.

- 32) J. Kohanoff, G. Galli, M. Parrinello, Theoretical-study of lic6, J. Phys. IV 1 (1991) 351–356.
- 33) R. Ahuja, S. Auluck, O. Eriksson, B. Johansson, Calculated electronic and optical properties of a graphite intercalation compound: Lic6, J. Phys.-Condes. Matter 9 (1997) 9845–9852.
- 34) C. Hartwigsen, W. Witschel, E. Spohr, Charge density and charge transfer in stage-1 alkali-graphite intercalation compounds, *Phys. Rev. B* 55 (1997) 4953–4959.
- 35) K. R. Kganyago, P. E. Ngoepe, Effects of local and gradientcorrected density approximations on the prediction of the intralayer lattice distance c, in graphite and lic6, *Mol. Simul.* 22 (1999) 39–+.
- 36) K. R. Kganyago, P. E. Ngoepe, C. R. A. Catlow, Ab initio calculation of the voltage profile for lic6, *Solid State Ion.* **159** (2003) 21–23.
- 37) A. Marquez, A. Vargas, P. B. Balbuena, Computational studies of lithium intercalation in model graphite in the presence of tetrahydrofuran, J. Electrochem. Soc. 145 (1998) 3328–3334.
- 38) Y. X. Wang, S. Nakamura, M. Ue, P. B. Balbuena, Theoretical studies to understand surface chemistry on carbon anodes for lithium-ion batteries: Reduction mechanisms of ethylene carbonate, J. Am. Chem. Soc. 123 (2001) 11708–11718.
- 39) Y. X. Wang, S. Nakamura, K. Tasaki, P. B. Balbuena, Theoretical studies to understand surface chemistry on carbon anodes for lithium-ion batteries: How does vinylene carbonate play its role as an electrolyte additive?, J. Am. Chem. Soc. **124** (2002) 4408–4421.
- 40) A. Marquez, P. B. Balbuena, Molecular dynamics study of graphite/electrolyte interfaces, J. Electrochem. Soc. 148 (2001) A624–A635.
- 41) Y. K. Han, S. U. Lee, J. H. Ok, J. J. Cho, H. J. Kim, Theoretical studies of the solvent decomposition by lithium atoms in lithiumion battery electrolyte, *Chem. Phys. Lett.* **360** (2002) 359–366.
- 42) C. M. Lee, S. H. Yang, B. J. Mun, P. N. Ross, Surface structure of lithiated graphite by x-ray photoelectron diffraction, *Surf. Sci.* 477 (2001) 126–132.
- K. Kobayashi, Electronic-structure of a stepped graphite surface, *Phys. Rev. B* 48 (1993) 1757–1760.